

FORTHCOMING PAPERS

Two-photon excitation of atomic oxygen using a Raman-shifted ArF-excimer laser

D.G. Fletcher (USA)

A photothermal experiment interpreted as evidence of electron-hole self-ordering in As-S chalcogenide glasses

B.P. Antonyuk, S.A. Kiselev (Russia); M.Bertolotti (Italy); G.L. Liakhov, A.A. Popescu, C. Sibilia (Moldavia)

Nonlinear emission in sodium vapour upon pulsed-laser excitation of the 4P levels

U. Domiaty, D. Gruber, L. Windholz, S.G. Dinev (Austria); M. Allegri, G. De Filippo, F. Fuso (Italy); R.-H. Rinkleff (Germany)

Applied Physics A 59, No. 4 (1994)

Solids and Materials

B. Aspacher, W. Frank, P. Kizler, K. Maier

The nature of the C-defects in nickel and their rôle in the interpretation of radiation damage in metals (*Invited Paper*) 339

T. Nshanian

Secondary-electron emission of ion-implanted semiconductors in scanning electron microscopy 349

P. Delaye, H.J. von Bardeleben, G. Roosen

Photorefractive measurements on electron-irradiated semi-insulating GaAs 357

D.R. Lee, T.P.J. Han, B. Henderson

Charge compensation and the luminescence of Cr³⁺ in KMgF₃ 365

H. Navarro, T. Timusk, W.R. Datars, D.C. Houghton

Photoconductivity of erbium-doped germanium 373

W. Meisel

Conversion-electron Mössbauer spectroscopy using ¹²¹Sb and a study of powdered α-Sb₂O₃ 381

G. Saffarini

Glass transition temperature and molar volume versus average coordination number in Ge_{100-x}S_x bulk glasses 385

A. Elfalaky

Structural and IR studies on Cu-Ti mixed ferrite 389

Surfaces and Multilayers

Y. Morishige, S. Kishida

Thick gold-film deposition by high-repetition visible pulsed-laser chemical vapor deposition 395

J.F. McGilp, M. Cavanagh, J.R. Power, J.D. O'Mahony

Spectroscopic optical second-harmonic generation from semiconductor interfaces 401

M. Vicanek, A. Rosch, F. Piron, G. Simon

Thermal deformation of a solid surface under laser irradiation 407

K.M. Colbow, S. Cramm, C. Malten, W. Eberhardt

Photoemission study of the growth of the NdF₃/Si(111) interface 413

J.J. Paggel, M. Förster

An artefact in scanning tunneling microscopy images of highly oriented pyrolytic graphite 419

K. Rottner, R. Helbig

Detection of C-H bonds in crystalline α-SiC by IR-absorption measurements 427

T. Serin, N. Serin

Determination of electron-diffusion length from photocurrent characteristics of the structure ITO/a-SiC:H (p-type)/a-Si:H/a-Si:H (n-type) / Pd 431

A. Markwitz, H. Baumann, E.F. Krimmel, R.W. Michelmann, C. Maurer, E.C. Paloura, A. Knop, K. Bethge

Chemical bonding and interface analysis of ultrathin silicon-nitride layers produced by ion implantation and Electron Beam Rapid Thermal Annealing (EB-RTA) 435

Rapid Communications

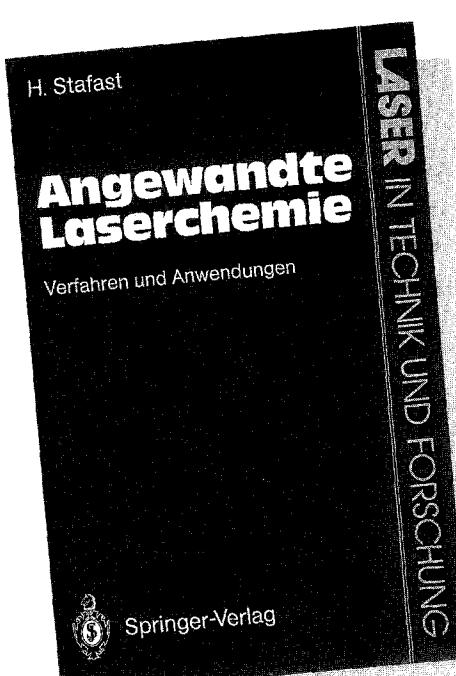
E. Kuphal

Phase diagram and LPE growth of strongly Sn- and Te-doped InGaAs 441

D.H. Baek, J.W. Chung

Vibrational property of the slow N₂⁺ ions deposited SiN_x films 445

Präzises Arbeiten mit Lasern



H. Stafast

Angewandte Laserchemie Verfahren und Anwendungen

1993. IX, 387 S. 86 Abb. 22 Tab.

(Laser in Technik und Forschung. Hrsg.: G. Herziger, H. Weber)
Geb. DM 118,-; öS 920,40; sFr 118,00 ISBN 3-540-56938-3

Die Laserchemie steht dank großer Fortschritte im Verständnis laserinduzierter Prozesse und in der Entwicklung der Lasertechnik nun auf der Schwelle zur praktischen Nutzung. Dieses Buch eines erfahrenen Industrieforschers legt die Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten laserchemischer Verfahren so anschaulich und knapp wie möglich dar. Es diskutiert daneben auch wirtschaftliche Erwägungen zum Lasereinsatz wie Betriebskosten, Wartungsarbeiten und Standzeiten. Das Buch bietet eine ausgezeichnete Einstiegshilfe für den Neuling. Dem Anwender wird eine Fundgrube praxis-spezifischer Details bereitgestellt bis hin zu einem Leitfaden für Prozeßkostenschätzung.



Springer

Preisänderungen vorbehalten

Tm.1118/MNT/V/2h

Springer-Verlag □ Heidelberger Platz 3, D-14197 Berlin, F.R. Germany □ 175 Fifth Ave., New York, NY 10010, USA □ 8 Alexandra Rd., London SW 19 7JZ, England □ 26, rue des Carmes, F-75005 Paris, France □ 37-3, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113, Japan □ Room 701, Mirrow Tower, 61 Mody Road, Tsimshatsui, Knowloon, Hong Kong □ Avenida Diagonal, 468-4 0C, E-08006 Barcelona, Spain □ Wesselényi u. 28, H-1075 Budapest, Hungary